

Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 0106U009492

Відкрита

Дата реєстрації: 18-09-2006

Статус виконавця: 17 – головний виконавець



1. Загальні відомості

Підстава для проведення робіт: 34 – договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

КПКВК:

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

7713 – кошти держбюджету

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 75

У тому числі по роках (тис. грн.):

Рік	Фінансування
-----	--------------

2. Замовник

Назва організації: Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 14312223

Адреса: вул. Академічна, 1, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61108, Україна

Підпорядкованість: Національна академія наук України

Телефон: 0573356522

3. Виконавець

Назва організації: Чернівецьке відділення Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича Національної академії наук України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05540043

Підпорядкованість: Національна академія наук України

Адреса: 58001, м. Чернівці, вул. Ірини Вільде, 5

Телефон: 25155

Інше: 20050

4. Співвиконавець

Назва організації: Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 14312223

Адреса: вул. Академічна, 1, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61108, Україна

Підпорядкованість: Національна академія наук України

Телефон: 0573356522

Назва організації: Національна академія наук України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270

Адреса: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Підпорядкованість: Кабінет Міністрів

Телефон: 380442346674

Телефон: 380442262347

Телефон: 380442396594

Телефон: 380442343243

E-mail: prez@nas.gov.ua

WWW: <http://nas.gov.ua>

Назва організації: МНТСП "Центр електронного матеріалознавства та прикладних проблем авіакосмічної техніки"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 24748157

Адреса: 03142, Київ, Кржижанівського ,3

Підпорядкованість:

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розробка нових напівпровідникових матеріалів на основі шаруватих кристалів та дослідження їх радіаційної стійкості в умовах ядерних випромінювань.

Назва роботи (англ)

Development of new semiconductor materials based on layered crystals and investigation of their radiation resistance under nuclear irradiation.

Мета роботи (укр)

Отримання та дослідження радіаційної стійкості діодних структур на основі шаруватих кристалів, що перспективні для використання в детекторах ядерних випромінювань з підвищеною надійністю та ресурсом роботи.

Мета роботи (англ)

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Інше

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Будуть виготовлені дослідні зразки на основі гетероструктур типу ITO-GaSe, власний оксид - InSe, p-n InSe, p-GaSe-n-InSe, проведені комплексні дослідження цих матеріалів та їх електрофізичних характеристик до і після опромінення.

Галузь застосування:

6. Етапи виконання

Номер	Початок	Закінчення	Звітний документ	Назва етапу
1	04.2006	12.2006	Остаточний звіт	Розробка нових напівпровідникових матеріалів на основі шаруватих кристалів та дослідження їх радіаційної стійкості в умовах ядерних випромінювань.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 45.09.35

Індекс УДК: 621.315.562, 621.315.592

8. Заключні відомості

Керівник організації:

Ковалюк Захар Дмитрович

Керівники роботи:

Ковалюк Захар Дмитрович

Відповідальний за подання документів: (Тел.:)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ



Юрченко Т.А.